

実用新案登録願



(4.000 A)

昭和55年 9月18日

特許庁長官 殿 考案の名称

原特許出願の表示

考 案 者

住

住 所

東京都中央区日本緬一丁目13番1号

トゥキョウテンキカガクコウギョウ 東京電気化学工業株式会社内

氏 名 騺(外2名)

実用新案登録出願人

所

中央区日本橋一丁目13番1号

【复化学工業株式会社 名 称

代表者

糟

代理 人

> 東京都中央区日本橋3丁目13番11号 (E 肵

> > 階(電話 273—6436番)

(6781)内 基 弘 **瓜**: 名

(外 1 名)

· 55 131695 1198





明 組 書

1考案の名称 積層コイル

2. 実用新案登録請求の範囲

- (1) 複数の磁性体層の積層体の層間から層間へと全体として周回パターンを形成するように線状導体を延在させ、前配線状導体の少くとも始端及び終端部分の周回パターン部分を覆う非磁性体層を設け、さらに前記始端及び終端に接続する外部端子を膜状に形成して成る開磁路形積層コイル。
- (2) 非磁性体層は離状導体の始端及び終端を覆う層と、磁性体の積層体の中間部分に形成される層とから成つていることを特徴とする第1項記載の機階コイル。

3.考案の詳細な説明

本考案は横層コイルで関し、特に開磁路型コイルに近似した積層コイルに関する。

最近積層技術を応用した積層コイル が提案され

従つて、本考案は開啟路型の積層コイルを提供することを目的とする。本考案積層コイルは積層の遺程で非磁性体層または低速磁率層を少くとも2層、好ましくは3層製けて関磁路ができる余地を出来るだけ減じたととにより直流重量特性の良い積層コイルを提供する。少くとも2層の非磁性

体層又は低透磁率層は積層コイルの表裏に形成され、しかもコイル形成用導体はこの層の面まで積層される。そして開磁路性をさらに増大させるために、積層体の中間部分の1個所にもう一層の非磁性体層又は低透磁率層を設けるとともある。

は単一部品の製造を説明するが、多数の部品を並 行的に同時製造する方が実際的であることに注意 すべきである。

第1図に示すよりに、先ず非磁性体層1を形成 する。その上に第2図に示すよりにコイル形成用 の導体2を線状に印刷し、その際に導体の左端を を非磁性体層1の左端に露出させる。第3図の工 程へ移り、磁性体層4を導体2の一端を残して下 磨の左應へ印刷または積層する。次に第4図のよ うに釣形の導体 5 を導体 2 の末端へ接続するよう に印刷する。さらに第 5 図のように磁性体層 6 を 今度は積層体の右半分に積層する。以下必要なタ ーン数が得られるまで第2凶から第5図までの工 程を報返すが、図を見易くするため反復工程は省 略する。第6図の工程において、さらに導体5に 接続する鈎形の導体フを印刷してその右端を積層 体の右辺に引出す。その上にさらに層1と同様な 非配性体層8を印刷または積層して積層工程を終 り、次に所定の腐温で能成して一体化した焼結体 とする。次に第8回のように左右に露出する導体 を引出端 a 、 b に接続する外部 媚子 9 、 1 D を例えば銀ペーストの焼付けで形成する。第9 図は完成した積層コイルの立断面図である。この断面で破路を検討すると、非磁性層 1 、 8 は g i 、 g s 、 g s 、 g s の 4 個所に空間相当の磁気抵抗を与える。従つて、この積層コイルは開磁路に近い磁路を有している。

第10回は本発明の変形例を示すもので、第2回から第6回までの工程を反復する中間段階で一層の非磁性体12を介在させ、他は第1回ないし第8回までの工程を行つて得た横層コイルである。本例によると、第9回に示したgェ〜g。に相当する個所の他に、g。、g。にも空隙を有する積層コイルとなるから、等価的にほぼ第11回の開磁路コイルが得られる。

従つて、本考案の積層コイルによると、直流重 豊特性のすぐれた積層コイルが提供できる。

4.図面の簡単な説明

第1図ないし第8図は本考案の第1実施例によ

公開実用 昭和57一55918

る機層コイルの製造するための順次工程を示す平面図、第9図は同機層コイルの斯面図、第10図は本考案の第2実施例による機層コイルの斯面図、及び第11図は等価的に示した本考案の機層コイルの正面図である。図中主な部分は次の通りである。

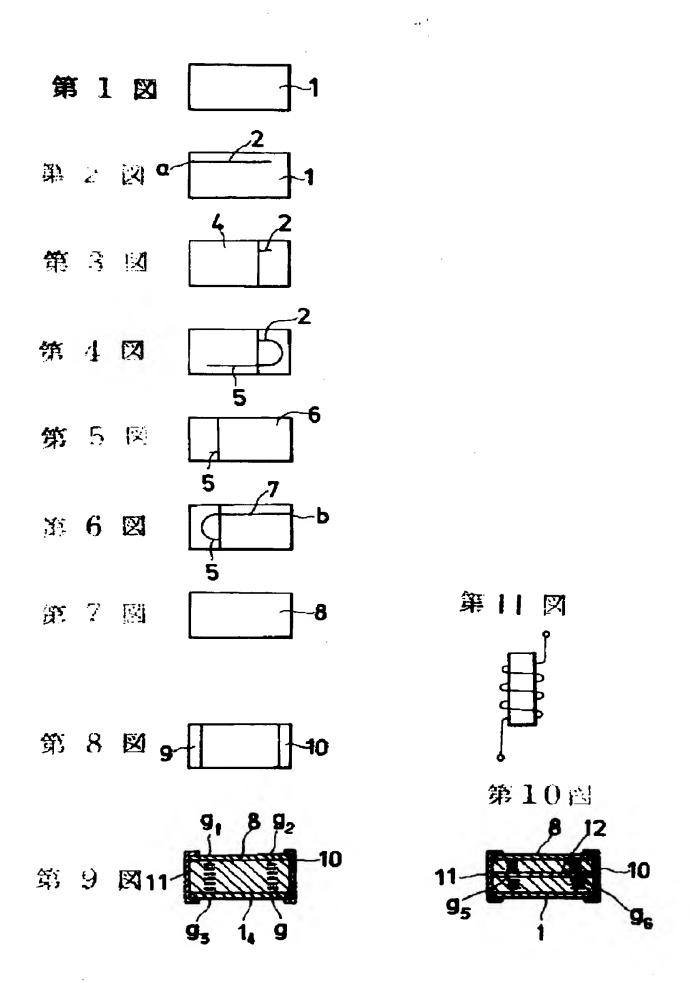
1、8、12;非磁性体層

4、6: 磁性体層

2、5、7:コイル形成用導体

9、10:外部端子

代理人の氏名 倉 内 基 弘 英



55918

代理人倉内基弘代理人倉橋縣



添聞書類の目録

2 (1) 明 翻 番

1 通

/ (2) 図

Ħ

1 遊

- , (3) 委 任 状

通

前記以外の考案者または代理人

考 案 者

チエウオウクニホンパシ

住 所 東京都中央区日本衛一丁目13番1号

トウャョウアンキカガクコウギョウ ナイ東京電気化学工業株式会社内

氏名福 田 次 男

d

住 所 同 上

氏名佐 本 融 治

代 珽 人

住 所 東京都中央区日本橋3丁目13番11号

抽騰工業会館 3 階 (電話 273-6436 香)

氏 名 (7563) 弁理士 倉 橋



11/18

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.